

## A92

硅 PNP 平面开关晶体管芯片(4 " )

### ■用途:

\*高压放大器

\*通讯产品中的高压开关线路

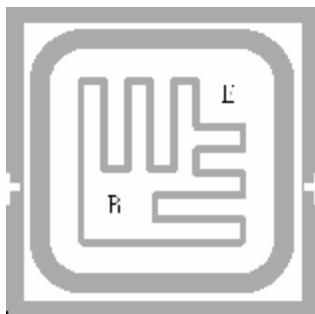
### ■特征:

\*与 A42 配对

\*集电极电流:0.5A

\*有效管芯数(只):18250

### ■芯片示意图



### ■芯片结构

芯片尺寸	620 μ m × 620 μ m
压焊区尺寸	基 区 128.5 μ m × 128.5 μ m 发射区 144.5 μ m × 144.5 μ m
芯片厚度	220 ± 10 μ m
锯片槽宽度	60 μ m
金属层	正面:Al 1.85 ± 0.15 μ m 背面:Au 1.1 ± 0.2 μ m

### ■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	单位
集电极--基极击穿电压	BV <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> =-100 μ A, I <sub>E</sub> =0	-300		V
集电极--发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =-1mA, I <sub>B</sub> =0	-300		V
发射极--基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =-100 μ A, I <sub>C</sub> =0	-6		V
集电极--基极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =-200V, I <sub>E</sub> =0		-500	nA
发射极--基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =-4V, I <sub>C</sub> =0		-500	nA
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =-10V, I <sub>C</sub> =-10mA	60	300	
集电极--发射极饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-20mA, I <sub>B</sub> =-2mA		-0.5	V
基极--发射极饱和电压	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =-20mA, I <sub>B</sub> =-2mA		-1.0	V